


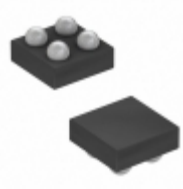
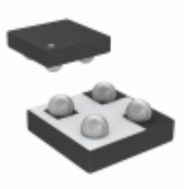
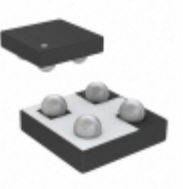


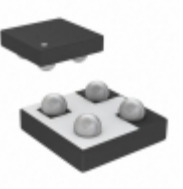
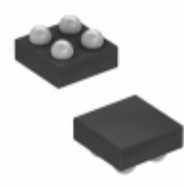
	<p>SI8481DB-T1-E1</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI8481DB-T1-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 9.7A 4-MICROFOOT</p> <p>Datenblätter:  SI8481DB-T1-E1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8481DB-T1-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 9.7A 4-MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-MICRO FOOT® (1.6x1.6)
Serie	TrenchFET® Gen III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.8W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	4-UFBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2500pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.7A (Tc)

SI8481DB-T1-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8481DB-T1-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8481DB-T1-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI8481DB-T1-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI8489EDB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8473EDB-T1-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8475EDB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8483DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 16A MICROFOOT</p>
 <p>SI8481DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9.7A 4- MICROFOOT</p>	 <p>SI8487DB-T1-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V MICROFOOT</p>	 <p>SI8473EDB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8487DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V MICROFOOT</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8481DB-T1-E1 Vishay / Siliconix	SI8481DB-T1-E1 Datenblatt	SI8481DB-T1-E1-Datenblätter	SI8481DB-T1-E1 PDF	Vishay / Siliconix SI8481DB-T1-E1
SI8481DB-T1-E1 Electronic	SI8481DB-T1-E1-Komponenten	SI8481DB-T1-E1-Verteiler	SI8481DB-T1-E1-Bild	SI8481DB-T1-E1-Teil
SI8481DB-T1-E1 Preis	SI8481DB-T1-E1 Hersteller	SI8481DB-T1-E1 Bild	SI8481DB-T1-E1 Aktie	SI8481DB-T1-E1 Inventar
SI8481DB-T1-E1 Neu	SI8481DB-T1-E1 Original	SI8481DB-T1-E1 garantiert	SI8481DB-T1-E1 RFQ	SI8481DB-T1-E1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited